



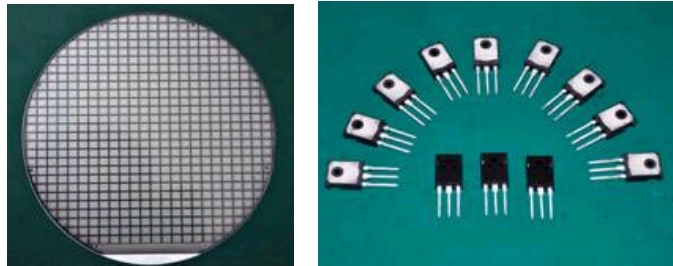
## 新闻动态

- ▶ 图片新闻
- ▶ 头条新闻
- ▶ 综合新闻
- ▶ 学术活动
- ▶ 科研动态
- ▶ 通知公告
- ▶ 业内信息
- ▶ 合作交流

现在位置: 首页 > 新闻动态 > 科研动态

### 微电子所成功研制国内首款可产业化的IGBT芯片

2010-04-01 | 编辑: | 【大中 小】 【打印】 【关闭】



日前,由中国科学院微电子研究所设计研发的15-43A /1200V IGBT系列产品(采用Planar NPT器件结构)在华润微电子工艺平台上流片成功,各项参数均达到设计要求,部分性能优于国外同类产品。这是国内首款自主研发可产业化的IGBT(绝缘栅双极晶体管)产品,标志着我国国产化IGBT芯片产业化进程取得了重大突破,拥有了第一条专业的完整通过客户产品设计验证的IGBT工艺线。

该科研成果主要面向家用电器应用领域,联合江苏矽莱克电子科技有限公司进行市场推广,目前正由国内著名的家电企业用户试用,微电子所和华润微电子将联合进一步推动国产自主IGBT产品的大批量生产。

IGBT作为新型电力电子器件的典型代表,广泛应用于智能电网、新能源发电、新能源汽车、工业变频、机电一体化、家用电器等诸多领域,是关系国家能源、交通、工业、家电等国计民生的核心电子元器件。由于国内IGBT制造工艺的落后,严重制约了我国IGBT产品的全国产化和产业化进程,技术和市场完全被少数国外企业垄断,尤其在高端应用领域。

定位于“满足国家战略需求”目标的中国科学院微电子研究所,在VDMOS、IGBT等功率器件领域的研制有二十多年的技术积累和基础,为我国微电子技术和产业发展做出了重要贡献,培育了一批优秀的功率器件和工艺设计研发团队,建设拥有世界先进的功率器件全参数测试平台,并正在建设全面的可靠性设计测试分析平台。为面向国家新兴战略产业,微电子所正致力于智能电网和电动汽车等高端应用领域的IGBT产品开发。

附件下载:

相关新闻:

微电子所6500V超高压IGBT研制取得重要突破  
微电子所1700V IGBT研制首次流片取得突破  
江绵恒副院长到微电子所调研



中国科学院微电子研究所版权所有 邮编：100029

单位地址：北京市朝阳区北土城西路3号，电子邮件：[webadmin@ime.ac.cn](mailto:webadmin@ime.ac.cn)

京公网安备110402500036号